

シリサイド系半導体 第9回夏の学校 プログラム

湯河原 万葉荘

7月29日(金)

受付 12:30~13:00

13:00~ 事務連絡 開会の挨拶

13:15~14:00 講義1 「 α -FeSi₂ 発光デバイス開発の現状と課題」(筑波大学 末益 崇)

14:00~14:50 講義2 「Si ナノ構造体の創製、不純物ドーピング、
表面・界面水素パッシベーションの研究」(筑波大学 村上浩一)

休憩 (チェックイン、部屋割り、入室)

15:25~16:15 講義3 「SiGe からの発光」 (東京大学 深津 晋)

16:15~17:00 一般講演(3件)

「Al_{0.70}Ga_{0.30}As:Er,Yb の発光における希土類元素 Yb の影響」

新井智幸(明治大D)

「石英基板上に成長した BaSi₂ 薄膜の光吸収特性の評価」

森田康介(筑波大M)

「絶縁基板上への α -FeSi₂ 薄膜の成長」

佐竹俊哉(静岡大M)

ソニー紹介

17:15~18:15 休憩 入浴

18:15~20:00 懇親会

20:30~22:00 ナイトセッション:自由発表、総合討論

22:00~23:30 研究会幹事会「シンポジウムの事務打ち合わせ」

7月30日(土)

9:00 ~ 9:45 講義4 「強誘電体薄膜におけるサイトエンジニアリングコンセプト」
(東京工業大学 舟窪 浩)

9:45 ~ 10:30 一般講演(3件)

「包析反応によるバルク -FeSi_2 の結晶生成」

三品明生(大阪大学 M)

「Si(001)基板上への Si/ -FeSi_2 /Si DH 構造の作製」

春原 剛(筑波大学 M)

「Ga-Al 混合溶媒を用いた -FeSi_2 結晶成長」

鈴木弘和(茨城大 M)

休憩

10:40 ~ 11:25 一般講演(3件)

「 -FeSi_2 /Si(111)ダブルヘテロ構造 LED における高温アニールによる EL 特性の改善」

宇賀神佑太(筑波大 M)

「PLD 室温成長で形成した Fe-Si 非晶質ドロップレットの形状への基板表面状態の影響」

佐々木貴久(都立科技大 M)

「MBE 法による $\text{Fe}_3\text{Si}/\text{CaF}_2/\text{Si}(111)$ 構造のエピタキシャル成長」

小林健一(筑波大 M)

11:25 ~ 12:05 講義5 「Fe-Al系合金の規則構造と回折: B2, DO3, L21」

(九州大学 桑野範之)

12:05 閉会のことば 事務連絡

現地解散